## на автореферат диссертации Чернякова Антона Евгеньевича «Особенности развития деградации внешней квантовой эффективности мощных синих светодиодов на основе квантоворазмерных InGaN/GaN структур», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 - «Физика полупроводников»

Квантоворазмерные светоизлучающие InGaN/GaN структуры являются основой для создания твердотельных энергосберегающих источников освещения. Полный переход на такие источники позволит уменьшить на $20 \%$ затраты электроэнергии на освещение. Однако существует ряд проблем, приводящих к нерентабельности такого перехода. Одна из проблем носит фундаментальный характер и вызвана особенностями развития деградации внешней квантовой эффективности (далее - ВКЭ) этих источников, такими, как катастрофический выход из строя, немонотонное (волнообразное) развитие этого процесса во времени. Причем природа этих явлений не выяснена, несмотря на многолетние усилия исследователей разных стран. В связи с этим цели и задачи, поставленные в диссертационной работе Чернякова A.E., являются актуальными и важными как с практической, так и с научной точки зрения. Развиваемый в диссертационной работе подход к изучению проблемы деградации ВКЭ мощных синих светодиодов на основе квантоворазмерных $\operatorname{InGaN} / \mathrm{GaN}$ структур и разработанные методы диагностики позволили Чернякову A.E. убедительно показать, что наблюдаемые особенности во многом определяются сложным характером организации наноматериала этих светодиодов. Он обусловлен способом получения InGaN/GaN структур в условиях самоорганизации, который приводит к формированию системы протяженных дефектов и локальных разно-размерных неоднородностей состава твердого раствора. Автором впервые показано, что процессы дефектообразования, развивающиеся в системе протяженных дефектов и в неоднородностях состава, приводят к немонотонному развитию деградации ВКЭ и катастрофическим отказам светодиодов, а также многообразию вариантов развития этих процессов на разных временных стадиях старения. Предложены простые методы выявления ненадежных светодиодов без долговременных испытаний. Подход, развитый в работе и разработанные

методы диагностики, перспективны для изучения деградации ВКЭ светодиодов на основе $\mathrm{A}^{3} \mathrm{~N}$ наноматериалов для зеленой и ультрафиолетовой областей.

Судя по автореферату и переченю опубликованных работ, автором выполнено обстоятельное обширное исследование, в рамках которого получен целый ряд новых научных и практически важных результатов, отвечающих поставленным в работе целям и задачам.

Несмотря на общее благоприятное впечатление, имеется замечание по оформлению: в подписях к рис.1. не приведен размер локальных областей перегрева. Это замечание не снижает научной значимости основных результатов работы.

Автореферат диссертации Чернякова A.E. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников», а Черняков А.Е. заслуживает присуждения ему искомой степени.

## Трофимов Юрий Васильевич

Республиканское научно-производственное унитарное предприятие «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси» (Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси»), директор, к.т.н.

Логойский тракт, д. 22, оф, 2207, 220090, г. Минск, Республика Беларусь
+37517281 1335 (раб.)
+375296651362 (моб.)
trofimov@inel.bas-net.by


